铝-钨丝混编阵的 Z-箍缩实验研究*

 宁 成^{1)*} 李正宏¹⁾ 华欣生¹⁾ 徐荣昆¹⁾ 彭先觉¹⁾

 许泽平¹⁾ 杨建伦¹⁾ 郭 存¹⁾ 蒋世伦¹⁾ 丰树平¹⁾

 杨礼兵¹⁾ 晏成立¹⁾ 宋凤军¹⁾ V. P. Smirnov²⁾

Yu. G. Kalinin²) A. S. Kingsep²) A. S. Chernenko²) E. V. Grabovsky³)

1(中国工程物理研究院,绵阳 621900)

² (Russia Research Center" Kurchatov Institute ", Moscow, Russia)
 ³ (Troitsk Institute for Innovation and Fusion Research, Troitsk, Russia)

(2003年7月18日收到2003年9月17日收到修改稿)

利用铝丝和钨丝混合编制的丝阵作为 Z-箍缩的负载,在俄罗斯 Kurchatov 研究所的 S-300 强流装置上对其 Z-箍 缩过程进行了实验研究,并与纯铝丝阵和纯钨丝阵的实验结果进行了比较.不同材料组成的丝阵的 Z-箍缩 x 射线 能谱之间有明显差异,混编丝阵的铝 K 壳层的 x 射线辐射强度比纯铝丝阵的弱,在纯钨丝阵 Z-箍缩中没有发现波 长小于 1.6nm 的线辐射.混编丝阵 Z-箍缩的 x 射线发光区域比纯铝丝阵的小,但比纯钨丝阵的大,混编丝阵的 x 射 线产额比纯铝丝阵的大,但比纯钨丝阵的略低.在驱动电流为 2.5—2.8MA 条件下,Z-箍缩的径向收缩比为 4—5 x 射线辐射脉冲脉宽为 25ns 左右,峰值为 0.3—0.5TW,总能量为 10—20kJ.激光探针的阴影像显示了丝阵等离子体形 成的细致过程,还表明了等离子体的边界面不够清晰,其不稳定性有明显的发展,内部有丰富的结构.

关键词:Z-箍缩,混编丝阵,S-300强流装置 PACC:5225P,5230

1.引 言

尽管在丝阵的 Z-箍缩实验中已经获得了很高 的 x 射线辐射功率和产额 ,但是要实现 Z-箍缩驱动 的 ICIC inertial confinement fusion),还需要大幅度地 提高其 x 射线辐射功率和产额 ,并且要使 x 射线辐 射脉冲符合其对氘氚靶丸等熵压缩和压缩的均匀性 和对称性以及光谱结构等方面的要求^[1→5].因此 ,一 方面要发展脉冲功率技术 ,提高 Z-箍缩的驱动电流 水平 ,另一方面要深入研究 Z-箍缩内爆物理过程、x 射线辐射脉冲形状和谱特征及其影响因素 .Z-箍缩 过程是一个高度的自组织过程 ,对于一定的加速器 , 通常仅能通过预先改变负载的几何结构和材料组成 (包括材料的类别、数量和质量)来影响、控制、改善 Z-箍缩内爆动力学过程、辐射脉冲形状和谱结构 .目 前 ,就负载几何结构变化对 Z-箍缩内爆动力学过程 和辐射脉冲形状的影响进行了较多的研究,发现双 层丝阵等复合负载能有效地抑制 Z-箍缩内爆过程 中磁流体力学不稳定性的发展,使收缩比增大,辐射 脉冲宽度缩小,辐射功率大幅度提高^[6-8].但对丝阵 材料组成对 Z-箍缩内爆动力学过程、辐射脉冲形状 和谱结构的影响研究开展尚不多.Lebedev 等人^[9]出 于研究丝阵中的电流分布和在丝阵中掺杂不同元素 材料对控制内爆过程和调制辐射谱结构的可能性而 对镍-铜、铝-钨丝等混编丝阵的 Z-箍缩过程进行了 初步实验研究.2003 年初,我们在俄罗斯 Kurchatov 研究所的 S-300 强流发生器上也开展了铝-钨丝混 编丝阵的 Z-箍缩实验研究,本文即报告这方面的初 步实验结果

2. 实验安排

S-300 强流发生器由 8 个模块组成 其设计电流

^{*} 国家自然科学基金(批准号:10035030和10375010)资助的课题.

[†] 通讯联系人.E-mail :ning_cheng@mail.iapcm.ac.cn

峰值可达 4MA, 上升时间为 100ns, 建成于 1995年. 每个模块由 80 个电容器组成 ,每个电容器的电容量 为 0.4µF 额定电压为 75kV ,但在实验时电压仅充到 44kV.S-300 强流发生器的额定储能为 720kJ, 但进 行实验时储能为 247.8kI.中国工程物理研究院和俄 罗斯 Kurchatov 研究所在 S-300 强流装置上进行 Z-箍缩联合实验,希望获得驱动电流峰值在 3MA 左右 的单质材料铝和钨丝阵内爆的总体特征(包括负载 电流电压波形、箍缩动力学过程和 x 射线辐射的物 理图像等),以及丝阵材料组成变化(铝-钨混编丝 阵 对内爆过程和辐射谱的影响 :比对中俄双方测试 结果:检验中方所研制丝阵的可用性:为7-箍缩过 程的数值模拟提供校验的实验数据,诊断系统如图 1 所示 此外还有监测 Marx 发生器、中储、磁绝缘传 输线和负载的电流、电压等设备。x射线辐射功率 仪的技术指标参见文献 101 它们的布置如图 1 所 示,真空靶室的直径约为1m,除云母x射线晶体谱 仪置于真空靶室内外 别的测试设备均置于靶室的 测试窗口上,实验中所用的丝阵直径和高均为 10mm.本文主要涉及铝-钨混编丝阵的实验结果.



图 1 测试系统布置示意图 1 为 x 射线辐射功率仪^[10],2 为可 见光条纹相机 ,3 为可见光三分幅照相 ,4 为多通道 x 射线光谱 仪 5 为激光阴影五分幅成像系统 6 为 x 射线十分幅成像系统 ,7 为针孔相机 8 为云母 x 射线晶体谱仪 9 为真空靶室

3. 实验结果与讨论

图 2 是由多通道 x 射线光谱仪测得的纯铝、铝-钨混编和纯钨丝阵在 Z-箍缩过程中辐射出的 x 射线 能谱图 .纯铝丝阵由 60 根直径为 18µm 的铝丝组成; 铝-钨混编丝阵由 30 根直径为 18µm 的铝丝和 30 根 直径为 6µm 的钨丝相间混编而成,铝、钨的质量比 为 1.255 纯钨丝阵由 80 根直径为 6µm 的钨丝组成. 它们的线质量分别为 412 ,370 ,431µg/cm,比较接近. 驱动电流的峰值为 2.5—2.8MA. 从图 2 可见,丝阵的材料及其组成对 x 射线的辐射能谱有明显的影响.在纯铝丝阵中,光子能量为 60eV 附近的 x 射线辐射最强;在混编丝阵和纯钨丝阵中光子能量均为 220eV 附近的 x 射线辐射最强.在所测量的光谱范 围内,纯钨丝阵的 x 射线辐射最强.实验中它们辐射出的 x 射线能量分别为 7,13 和 14kJ 左右.



图 2 x射线辐射能谱分布图 ■为 60 根铝丝(18µm)阵,●为 30 根铝丝(18µm)+30 根钨丝(6µm)阵,▲为 80 根钨丝(6µm)阵

图 3 是由 60 根直径为 18µm 的铝丝组成的纯铝 丝阵在 Z-箍缩过程中辐射出的线谱构成情况,它是 由云母 x 射线晶体谱仪拍摄到的, 左边第一条谱线 对应的能量为 2.3keV, 右边最后一条谱线对应的能 量为 0.78keV.铝的 K 壳层两个电子的电离能分别 为 2.08605 和 2.30416keV^[11].铝的 K 壳层辐射的特 征 谱 线 (谱 线 符 号 和 能 量) 如 下^[12]: KL 为 1.43894keV, KL 为 1.486295keV, KL 为 为 1.486708 keV , KM_1 为 1.55757keV, KM_2 1.55757keV, KM₃ 为 1.55757keV, KM₄ 为 1.55757keV, KM₅ 为 1.55757keV, K edge 为 1.559893keV, K edge(c)为1.55953keV.对比图 3 中 谱线能量可知,左起最亮的第二条谱线(其能量为 1.56keV)是铝的 KM 和 K 系列谱线的集合,但别的 谱线需要深入研究铝原子的各种可能跃迁及其概率 后才能确认,这是一项难度很大的工作,其中一些谱 线还可能是电极和电流回路材料的溅射所引起的杂 质谱线,也可能是强磁场的影响和等离子体的运动, 使原子的谱线发生了移动.并且,在Z-箍缩过程中 或在 7-箍缩过程中的某一时刻均存在不同离化态 的铝离子 因此谱线的跃迁 也就是光谱 非常复杂. 但该 Z-箍缩已使铝原子达到 K 壳层电离,产生 K 壳 层辐射.另外,在实验中发现,在铝-钨混编丝阵中测



图 3 纯铝丝阵的 x 射线辐射线谱(下面是线谱的波长标尺)



图 4 Z-箍缩过程的针孔相机图片 (a)为纯铝丝阵,1 2 3 所采 用的 Mylar 膜的厚度分别为 5,12 *0*µm;(b)为混编丝阵,三幅图 均采用 12µm 的 Mylar 膜 (c)为纯钨丝阵,1 2 3 所采用的 Mylar 膜的厚度同图(a)

图 4 是针孔相机拍摄到的照片.丝阵的组成与 图 2 中的情况完全相对应.从图 4 可以看到,纯铝丝 阵的发光区域最大,混编丝阵的次之,纯钨的最小, 相应地反映出它们箍缩状况的差异,纯钨丝阵箍缩 得最好,混编丝阵的次之,纯铝的最差.这与它们的 x射线辐射产额的相对大小符合.这也反映了不同 材料的等离子体形态和特征的差异,同时也表明,就 箍缩的稳定性而言,钨作为丝阵的材料较合适.



图 5 负载电压(曲线 a)和辐射功率(曲线 b)随时间的变化曲线



图 6 Z-箍缩过程的可见光条纹像

图 5 是负载(30 铝(18µm)+30 钨(6µm))的电 压波形曲线和它在箍缩过程中辐射出的 x 射线功率 随时间的变化曲线(曲线小幅振荡是测试环境中的 电磁干扰引起的).由图 5 可见,x 射线功率在负载 加上高电压 170ns 左右(已扣除电缆长短差异的影 响)后达到最大值(也就是等离子体箍缩到心时刻, 收缩比达到最大),经标定其最大值约为 0.5TW.x 射线辐射脉冲的半高宽(FWHM)为 25ns 左右(实验 中发现它与纯钨丝阵的差不多,但比纯铝丝阵的略 小).图 6 是可见光条纹相机拍摄到的 Z-箍缩动态过 程图.它非常直观地示出 Z-箍缩的全过程"潜伏" 期、快速箍缩、滞止阶段和飞散膨胀阶段.从图 6 中 可知负载的箍缩收缩比为 4—5,箍缩的平均速度为 3×10⁴ m/s;图 6 中标出收缩比最大时所对应的时刻 为 160ns,而图 5 中给出的为 170ns 左右.这时间的 差异反映了可见光条纹像给出的到心时刻较真正的 Z-箍缩到心时刻早,亦即从可见光条纹像来看它已 经箍缩到心,但如果从 x 射线条纹像来看它还在箍 缩,还没有箍缩到心.

以上给出的实验结果都是利用 Z-箍缩等离子 体发射出的 x 射线和/或可见光而进行被动方式测 量得到的,它们都不能很好地反映出等离子体内部 的信息,下面给出利用激光探针(YAG:Nd激光器, 二倍频激光波长为 532nm ,每一激光束能量为 20— 25mJ)进行主动方式测量,并可以反映等离子体内部 信息的测量结果,激光探针测量系统十分庞大而复 杂,该套测量系统详见文献 13].图 7 是铝-钨混编 丝阵 Z-箍缩等离子体激光探针系列阴影图,每幅图 相隔 10ns. 第三幅是等离子体箍缩到心附近时刻的 阴影像.图7中黑暗区域为等离子体的高温高密度 不透光区域 即该区域对探针激光的吸收很强 从而 激光几乎全被衰减掉,显示为黑暗,从图7可见(特 别是在计算机将图形放大后更清楚),等离子体的内 部结构十分丰富,等离子体的外界面不是光滑整齐 的 其界面上不稳定性的发展情况清晰可见 筹离子 体的外界面在本文测试条件下很难明确界定,在主 等离子体的周围还有稀薄等离子体,它展示了 7-箍 缩等离子体在箍缩过程中的外形变化特征和丰富的 内部结构及其发展变化情况.

在本次联合实验的激光探针实验结果中,从其 5 分幅阴影像中能看出丝阵等离子体初始形成过程 的仅有一发(12 铝(30μm)+12 钨(10μm)),其结果 中的两幅如图 8 所示(同样,其在计算机上放大后看 更为清楚).从 *t* = 47ns 时刻的阴影像可以清楚地看 出,每根丝(图中较粗的黑影代表铝丝,较细的黑影 代表钨丝)表面上的等离子体电晕一丝一丝地向对 称中心漂移;在驱动电流流过丝阵时,不同丝之间的 消融速率不同,同一根丝上不同地方的消融速率也 不相同,且有的丝已经断掉(图中已标明),有的丝位



(a)97ns



(b)107ns



(c)117ns



(d)127ns



(e)137ns 图 7 铝-钨混编丝阵的 Z-箍缩等离子体激光探针阴影图

置发生了移动;每根丝主要在朝向对称中心的一面 逐渐消融,直到丝被融断为止,但在丝的外侧面也能 看到一些凹凸不平的表面,说明丝的外侧面也有一 些微弱的消融.从 *t* = 57ns 和 *t* = 67ns 两幅阴影像 (因篇幅所限,这里没有附出)看,有些丝之间的等离 子体已经弥合,但从总体上还没有完全弥合好,图中 断开的铝丝还清晰可见,左外侧面可以看到流体力 学不稳定性在发展.到 *t* = 77ns 后,各丝之间的等离 子体已较好地弥合,但等离子体在径向和轴向的分







(b) *t* = 77ns 图 8 铝-钨混编丝阵的 Z-箍缩等离子体在不同时刻的阴影图

布不是十分均匀.同时还可以看到,流体力学不稳定 性有了进一步的发展,但在左侧面的发展更快一些, 已断开的铝丝仍然清晰可见.足见丝阵等离子体的 形成及其内爆是很复杂的过程.对混编丝阵和单一 材料丝阵^[14]Z-箍缩,在等离子体形成阶段均存在芯-晕等离子体结构,它们的电晕均成丝地向对称中心 轴漂移,形成先驱等离子体,但因不同材料的丝之间 的导电性能和丝的粗细的差异,会导致丝的消融、电 晕漂移、芯-晕等离子体结构等方面的差异.这些方 面今后还需深入研究.

丝阵(负载)材料组成的改变对其箍缩过程的影响不难理解.不同材料的导电性能不同,导电性能好的丝开始时通过绝大部分的电流,因而它比导电性能差的丝先熔化和箍缩.当它箍缩到一定程度后,因其电感(或许还有反常电阻)增加,而使大部分电流转到导电性能较差的丝(等离子体)中流过,从而使它继续熔化和箍缩.在铝-钨混编丝阵的 Z-箍缩中, 铝的电导性能比钨的好,且铝丝的横截面积比钨丝的大,因此铝丝的电阻要比钨丝的小得多,从而开始时铝丝中通过绝大部分的电流,它熔化得快,并可能 先箍缩(但与丝的相对粗细有关).因此,通过改变丝 阵(负载)的材料构成,可以控制 Z-箍缩动力学过 程,从而 x 射线辐射的脉冲形状也就相应地改变.另 一方面,不同的材料,其原子结构及其电离能就不 同,因此,丝阵材料的种类、数量和质量等的改变必 定要对其 x 射线辐射的光谱结构产生影响,从而可 以通过改变组成丝阵的材料的种类、数量和质量来 产生满足某些特定光谱结构要求的 x 射线辐射(如 ICF 中要求的平衡 x 射线辐射).联合实验的打靶发 数很有限,这里的实验是初步的,今后还要对组成丝 阵的材料种类、数量和质量的各种组合,以及不同材 料组成的复合负载的 Z-箍缩过程,及其辐射特性进 行大量研究,以摸清其规律.

4.结 论

在 Kurchatov 研究所的 S-300 强流发生器上,对 铝-钨丝混编阵的 Z-箍缩动力学过程及其 x 射线辐 射特征进行了初步研究,得到了一些实验数据和 Z-箍缩物理图像,丝阵的材料组成对丝阵的 7-箍缩内 爆动力学过程和辐射谱有较大影响,首先丝阵材料 的组成对 7-箍缩动力学过程有明显的影响 混编丝 阵的 x 射线发光区域比纯铝丝阵的小,但比纯钨丝 阵的大 这实际上表明了箍缩状况的差异 同时这与 它们辐射产额的相对大小相符合,其次组成丝阵的 材料的改变对 x 射线辐射功率谱也有明显的影响, 混编丝阵的铝 K 壳层的 x 射线辐射强度比纯铝丝阵 的弱,且在纯钨丝阵的实验中没有观测到波长小于 1.6nm的 x 射线辐射.铝-钨混编丝阵 Z-箍缩的 x 射 线脉冲半高宽为 25ns 左右,与纯钨丝的相近,但比 纯铝丝的略小.当驱动电流在 2.5-2.8MA 条件下, 7. 筛缩的径向收缩比为 4—5 x 射线辐射脉冲的最 大功率在 0.3-0.5TW 左右,辐射总能量为 10-20kI.激光探针阴影像表明,在等离子体形成阶段存 在芯-晕等离子体结构,它们的电晕成丝地向对称中 心轴漂移;在 Z-箍缩过程中,磁流体力学不稳定性 有明显的发展 Z-箍缩等离子体的界面不够光滑 也 不够清晰 在主等离子体的周围还有稀薄等离子体 , 从而表现出非常丰富而复杂的内部结构.

曾与杨震华研究员和丁宁研究员就本文进行过有益的 讨论,他们提出了一些修改意见,就铝丝阵 Z-箍缩辐射线谱 方面曾与方泉玉研究员、孟续军研究员、颜 君副研究员进行 过讨论,特此一并致谢.

2249

- [2] Vesey R A et al 2003 Phys. Rev. Lett. 90 35005-1
- [3] Bennett G R et al 2002 Phys. Rev. Lett. 89 245002-1
- [4] Hanson D L et al 2002 Phys. Plasmas 9 2173
- [5] Ning C, Yang Z H and Ding N 2003 Acta Phys. Sin. 52 415 (in Chinese)[宁 成、杨震华、丁 宁 2003 物理学报 52 415]
- [6] Deeney C et al 1998 Phys. Rev. Lett. 81 4883
- [7] Sze H et al 2000 Phys. Plasmas 7 4223
- [8] Deeney C et al 1993 Phys. Fluids B 5 992

- [9] Lebedev S V et al 2002 Phys. Plasmas 9 2293
- [10] Xu R K et al 2003 Acta Phys. Sin. 52 1203(in Chinese] 徐荣昆 等 2003 物理学报 52 1203]
- [11] Cowan R D 1981 The Theory of Atomic Structure and Spectra (California : California University Press)p12
- [12] Deslattes R D and Kessler E G Jr 2003 Rev. Mod. Phys. 75 35
- [13] Kalinnin Yu G et al 2002 Plasma Phys. Rep. 28 790
- [14] Lebedev S V et al 2001 Phys. Plasmas 8 3734

Experimental studies of Z-pinches of mixed wire array with aluminum and tungsten *

Ning Cheng¹)[†] Li Zheng-Hong¹) Hua Xin-Sheng¹) Xu Rong-Kun¹)

Peng Xian-Jue¹) Xu Ze-Ping¹) Yang Jian-Lun¹) Guo Cun¹) Jiang Shi-Lun¹)

Feng Shu-Ping¹) Yang Li-Bing¹) Yan Cheng-Li¹) Song Feng-Jun¹)

V. P. Smirnov²) Yu. G. Kalinin²) A. S. Kingsep²) A. S. Chernenko²) E. V. Grabovsky³)

¹⁾(China Academy of Engineering Physics , Mianyang 621900 ,China)

 $^{2}\$ (Russia Research Center " Kurchatov Institute " , Moscow , Russia)

³ (Troitsk Institute for Innovation and Fusion Research , Troitsk , Russia)

(Received 18 July 2003; revised manuscript received 17 September 2003)

Abstract

In the form of joint experiment between China and Russia, the experimental studies of Z-pinches of mixed wire array of aluminum (A1) and tungsten (W) were carried out on S-300 generator ,which was located on Kurchatov Institute of Russia. The experimental results were compared with those of single A1 array and single W array, respectively. There are obvious difference between mixed one and single one in their photon spectral distributions. The intensity of K-series emission lines from the mixed wire array Z-pinch is lower than that from single A1 array. The radiated lines with wavelengths less than 1.6nm were not found in single W array Z-pinches. In the Z-pinch processes, the area radiating x-arys in mixed wire array is smaller than that of single A1 array, but is larger than that of single W array. The radiated energy from mixed wire array Z-pinch is higher than that from single W array. The radiated from Z-pinches with a maximal power 0.3—0.5TW and total energy 10—20kJ is about 25ns, which radiated from Z-pinches with a radial convergence of 4—5 on S-300 generator. The shadow photograph of the mixed wire-array Z-pinch plasma by laser probe shows that the core-corona configuration was formed and the corona was moving toward the center axis during the wire-array plasma formation, that the interface of the plasma is not clear, and that therer are a number of structures inside. They also suggests that there was an obvious development of Magneto Rayleigh-Taylor instability in the Z-pinch process as well.

Keywords : Z-pinch , mixed wire array , S-300 generator PACC : 5225P , 5230

^{*} Project supported by the National Natural Science Foundation of China Grant Nos. 10035030 and 10375010).

 $^{^{\}dagger}$ Corresponding author. E-mail <code>:ning _ cheng@mail.iapcm.ac.cn</code>